(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年10月7日(07.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/085523 A1

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/003964

C08J 7/00, C08L 9/00

(22) 国際出願日:

2004年3月23日(23.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-086775

2003年3月27日(27.03.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1048410 東 京都中央区築地五丁目6番10号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 青山 彰夫 (AOYAMA, Teruo) [JP/JP]; 〒1048410 東京都中央区 築地五丁目6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP). 古 市 稔 (FURUICHI, Minoru) [JP/JP]; 〒1048410 東京都 中央区築地五丁目6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 白井 重隆 (SHIRAI, Shigetaka); 〒1050003 東 京都港区西新橋2丁目2番5号 吉川ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID. IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: RESIN MOLDING AND WORKED ITEM THEREFROM

(54) 発明の名称: 樹脂成形品およびその加工品

(57) Abstract: A resin molding obtained by exposing to electron beams a resin molding composition comprising 100 to 60 parts by mass of syndiotactic 1,2-polybutadiene of 5% or higher crystallization degree (A) and 0 to 40 parts by mass of other thermoplastic mass of syndiotactic 1,2-polybutadiene of 3% of higher crystallization degree (N) and 6 to 16 parts by fines of other destruction polymer (B). The 50% stress of resin molding after exposure to electron beams (50%M:M2) is in the range of 1.01 to 2.5 times the 50% stress before exposure to electron beams (50%M:M1), and the resin molding is resistant to steam sterilization. The resin molding excels in not only flexibility and hardness but also resistance to steam sterilization, and thus is suitable for medical uses such as an infusion tube, an infusion container, a catheter, etc.

(57) 要約: (A) 結晶化度が5%以上であるシンジオタクチック1, 2-ポリブタジエン100~60質量部、 ならびに(B) 他の熱可塑性ポリマー0~40質量部を含有する樹脂がある電子線照射して得られる成形品で あって、電子線照射後の成形品の50%応力(50%M:M2)が電子線照射前の50%応力(50%M:M1) の1.01~2.5倍であり、かつ耐蒸気滅菌性を有する樹脂成形品。柔軟性と硬度とに優れるとともに、耐蒸気 滅菌性に優れ、輸液用チューブ、輸液用容器、およびカテーテルなどの医療用途に有用である。



明細書

樹脂成形品およびその加工品

5 技術分野

本発明は、シンジオタクチック 1, 2 ーポリブタジエン含有組成物からなる樹脂成形品を電子線照射して得られる成形品に関する。さらに詳しくは、柔軟性と硬度とに優れ、かつ耐蒸気滅菌性を有するシンジオタクチック 1, 2 ーポリブタジエン含有成形品に関する。

10

15

背景技術

シンジオタクチック 1, 2 - ポリブタジエンは、プラスチック(硬度)と ゴム(弾性、柔軟性)との性質を併せ持つ熱可塑性エラストマーであり、一 定の結晶性を持ちながら、汎用されているポリマー加工機によって容易に成 形することが可能であるため、各種工業用品に用いられるようになっている。

特に、耐ガス透過性、透明性に優れ、可塑剤を多量に必要とする塩化ビニル系樹脂などに較べ、可塑剤無添加で成形加工でき、柔軟かつ自己粘着性を適度に有するので、輸液用チューブ、およびカテーテルなどの医療用途への応用が拡大しつつある。

20 しかし、シンジオタクチック1, 2 -ポリブタジエンは、結晶化度が低い 場合には、融点が70~95℃と低く、これを輸液用チューブや輸液容器、 およびカテーテルなどの医療用具に用いて、蒸気滅菌すると、耐熱性に乏し く、実用上問題となることがあった。

5

15

20

シンジオタクチック1,2ーポリブタジエンの、プラスチック(硬度)と ゴム(弾性、柔軟性)との性質を併せ持つ熱可塑性エラストマーであるとい う特性を保持しつつ、性能バランスの不足を解消する方法として、限定され た波長の紫外線を照射することにより成形物の表層のみを架橋させて硬化さ せる方法が提案されている(特開2000-129017号公報)。この方 法は、医療用部材としての、柔軟性、透明性および耐熱性(耐高圧蒸気滅菌 性)の性能バランスの向上の点では相応の効果を発揮するものである。

また、より硬質な表面を得るため、電子線を照射する方法も種々提案され 10 ている。これらの方法は、耐傷付き性については一定の効果を発揮するもの である。

しかしながら、上記公報に開示された方法により得られる成形物は、限定された領域の波長の紫外線照射によって表層のみを架橋するものであるため、例えば医療用チューブの内部の耐熱性については、必ずしも十分に満足し得るものではない。また、従来の電子線を用いる方法は、成形物の内部をも過剰に硬質化してしまい、シンジオタクチック1,2一ポリブタジエンが有する1つの性質である柔軟性がほとんど失われてしまうという問題がある。

本発明は、輸液用チューブ、輸液用容器、およびカテーテルなどの医療用 途などに有用な、柔軟性と硬度とに優れるとともに、耐蒸気滅菌性に優れた シンジオタクチック 1, 2 ーポリブタジエン含有成形品を提供することを目 的とする。

発明の開示

15

本発明は、(A) 結晶化度が5%以上であるシンジオタクチック1,2-ポリブタジエン100~60質量部、ならびに(B)ポリエチレン、ポリプ ロピレン、スチレンーブタジエンースチレンブロック共重合体 (SBS)、 スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体(SIS)、これらの水 素化物 (SEBS、またはSEPS)、上記シンジオタクチック1,2-ポ リブタジエン以外のポリブタジエン(BR)、ABS樹脂、ポリイソプレン、 ポリエチレン (LLDPE、ULDPE、またはLDPE)、エチレン一酢 酸ビニルコポリマー、エチレン-アクリル酸エステルコポリマー、およびエ チレン-メタクリル酸コポリマーの群から選ばれた少なくとも1種の熱可塑 10 性ポリマー0~40質量部 [ただし、(A) + (B) = 100質量部] を含 有する樹脂成形品を電子線照射して得られる成形品であって、電子線照射後 の成形品の50%応力(50%M:M2)が電子線照射前の50%応力(5 0%M:M1)) の1. 01~2. 5倍であり、かつ耐蒸気滅菌性を有する ことを特徴とする樹脂成形品に関する。

ここで、樹脂成形品のヘイズ値は、50以下の透明性を有するものが好ま しい。

また、電子線照射後の樹脂成形品のトルエン不溶分は、通常、50~99 質量%である。

さらに、電子線照射量は、電子線加速電圧(kV)と照射線量(Mrad) 20. の積で2~1, 000, 000 (kV·Mrad) である。

樹脂成形品の具体例としては、チューブ、シート、フィルム、バッグ、お

よびコネクターの群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。

これらの樹脂成形品は、ハロゲン原子の含有量が50ppm以下であることが好ましい。

本発明の樹脂成形品は、特に医療用途に応用される。

5 さらに、本発明は、上記樹脂成形品を加工して得られる食品用途、履き物 用途、車両用途、電線被覆用途などの加工品に関する。

発明を実施するための最良の形態

(A) シンジオタクチック1,2-ポリブタジエン

本発明に用いられる(A)シンジオタクチック1,2ーポリブタジエンは、結晶化度が5%以上、好ましくは10~40%の結晶性を有するシンジオタクチック1,2ーポリブタジエンであり、その融点は、好ましくは50~130℃、さらに好ましくは60~120℃の範囲にある。結晶化度・融点がこの範囲にあることにより、引張強度、引裂強度などの力学強度と柔軟性に
 優れる結果となる。

本発明に用いられる (A) シンジオタクチック 1 , 2 -ポリブタジエンは、例えば、1 , 2 -結合含有量が 7 0 %以上のものであり、例えば、コバルト化合物およびアルミノオキサンを含有する触媒の存在下に、ブタジエンを重合して得られるものであるが、この製造方法に限定されるものではない。

20 本発明に用いられる(A)シンジオタクチック1,2ーポリブタジエンの ブタジエン結合単位における1,2ー結合含有量は、通常、70%以上、好 ましくは80%以上、さらに好ましくは90%以上である。1,2ー結合含

20

有量が70質量%以上であることにより、当該1,2-ポリプタジエンが良好な熱可塑性エラストマーとしての性質が発揮される。

本発明に用いられる(A)シンジオタクチック1,2ーポリブタジエンは、ブタジエン以外の共役ジエンが少量共重合していてもよい。ブタジエン以外の共役ジエンとしては、1,3ーペンタジエン、高級アルキル基で置換された1,3ーブタジエン誘導体、2ーアルキル置換-1,3ーブタジエンなどが挙げられる。このうち、高級アルキル基で置換された1,3ーブタジエン誘導体としては、1ーペンチル-1,3ーブタジエン、1ーヘキシル-1,3ーブタジエン、1ーヘプチル-1,3ーブタジエン、1ーオクチル1,3ーブタジエンなどが挙げられる。

ここで、2-アルキル置換-1, 3-ブタジエンの代表的なものは、<math>2-メチル-1, 3-ブタジエン (イソプレン)、2-エチル-1, 3-ブタジ エン、2-プロピル-1, 3-ブタジエン、2-イソプロピル-1, 3-ブタジエン、2-イソプロピル-1, 3-ブタジエン、2-イソプチル-1, 3-ブタジエン、2-イソプチル-1, 3-ブタジエン、2-イソアミル-1, 3-ブタジエン、2-イソアミル-1, 3-ブタジエン、2-(4)0 ロヘキシル-1, 3-(4)0 カジェン、2-(4)1 カジェン、2-(4)2 カジェン、2-(4)3 カジタジエン、2-(4)4 カチル-1, 3-(4)5 カジェン、2-(4)5 カチル-1, 3-(4)7 カチル-1, 3-(4)7 カチェン、2-(4)7 カチル-1, 3-(4)7 カチェンなどが挙げられる。これらの共役ジェンのなかで、ブタジエンと共重合される好ましい共役ジェンとしては、2-(4)7 カテル-1, 3-(4)7 カチェンと対挙げられる。重合に供される単量体成分中のブタジエンの含有量は2-(4)7 カテル-2 は、2-(4)7 カテル-3 は2-(4)7 カテル-3 は2-(4)7 カテル-4 は2-(4)7 カテル-5 は2-(4)7 カテル-1 は2-(4)9 が表げられる。

10

は70モル%以上が好ましい。

本発明で用いられる(A)シンジオタクチック1,2一ポリプタジエンは、上述したように、例えば、コバルト化合物およびアルミノオキサンを含有する触媒の存在下に、プタジエンを重合して得られる。上記コバルト化合物としては、好ましくは炭素数4以上のコバルトの有機酸塩を挙げることができる。このコバルトの有機酸塩の具体例として、酪酸塩、ヘキサン酸塩、ヘプチル酸塩、2ーエチルーヘキシル酸などのオクチル酸塩、デカン酸塩や、ステアリン酸、オレイン酸、エルカ酸などの高級脂肪酸塩、安息香酸塩、トリル酸塩、キシリル酸塩、エチル安息香酸などのアルキル、アラルキル、アリル置換安息香酸酸塩やナフト工酸塩、アルキル、アラルキルもしくはアリル置換ナフト工酸塩を挙げることができる。これらのうち、2ーエチルヘキシル酸のいわゆるオクチル酸塩や、ステアリン酸塩、安息香酸塩が、炭化水素溶媒への優れた溶解性のために好ましい。

上記アルミノオキサンとしては、例えば下記一般式(I)または一般式(II) 15 で表されるものを挙げることができる。

$$R_2$$
-Al- $(OAl)_m$ -OAl R_2 -----(I)

 R

----(II)

 $(OAl)_{m+2}$
 R

この一般式(I)あるいは(II)で表されるアルミノオキサンにおいて、 Rはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などの炭化水素基であり、 好ましくはメチル基、エチル基であり、特に好ましくはメチル基である。また、mは、2以上、好ましくは5以上、さらに好ましくは10~100の整数である。アルミノオキサンの具体例としては、メチルアルミノオキサン、エチルアルミノオキサン、プロピルアルミノオキサン、ブチルアルミノオキサンなどを挙げることができ、メチルアルミノオキサンが特に好ましい。

重合触媒は、上記コバルト化合物とアルミノオキサン以外に、ホスフィン化合物を含有することが極めて好ましい。ホスフィン化合物は、重合触媒の活性化、ビニル結合構造および結晶性の制御に有効な成分であり、好ましくは下記一般式 (III) で表される有機リン化合物を挙げることができる。

10 $P(Ar)_n(R^{\prime})_{3-n}$ (III)

一般式(III)中、Arは下記で示される基を示す。

$$\begin{array}{c} R^1 \\ \hline \\ R^3 \end{array}$$

15

(上記基において、 R^1 , R^2 , R^3 は、同一または異なって、水素原子、炭素数が好ましくは $1\sim 6$ のアルキル基、ハロゲン原子、炭素数が好ましくは $1\sim 6$ のアルコキシ基または炭素数が好ましくは $6\sim 1$ 2のアリール基を表す。)

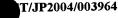
また、一般式 (III) 中、R $\dot{}$ はシクロアルキル基、アルキル置換シクロアルキル基を示し、n は $0\sim3$ の整数である。

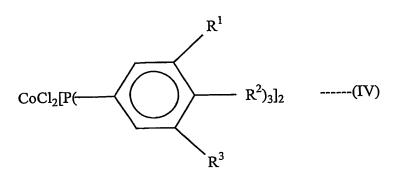
一般式(III)で表されるホスフィン化合物としては、具体的に、トリー (3-メチルフェニル) ホスフィン、トリー(3-エチルフェニル) ホスフ ィン、トリー(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン、トリー(3,4-ジメチルフェニル) ホスフィン、トリー(3ーイソプロピルフェニル)ホス フィン、トリー(3-t-ブチルフェニル)ホスフィン、トリー(3,5-ジエチルフェニル) ホスフィン、トリー(3-メチル-5-エチルフェニル) ホスフィン)、トリー (3-フェニルフェニル) ホスフィン、トリー (3, 4, 5-トリメチルフェニル) ホスフィン、トリー(4-メトキシー3, 5 ージメチルフェニル) ホスフィン、トリー(4-エトキシー3,5-ジエチ ルフェニル) ホスフィン、トリー(4ーブトキシー3, 5ージプチルフェニ 10 ル) ホスフィン、トリ (p-メトキシフェニルホスフィン)、トリシクロへ キシルホスフィン、ジシクロヘキシルフェニルホスフィン、トリベンジルホ スフィン、トリ (4-メチルフェニルホスフィン)、トリ (4-エチルフェ ニルホスフィン)などを挙げることができる。これらのうち、特に好ましい ものとしては、トリフェニルホスフィン、トリー (3-メチルフェニル) ホ 15 スフィン、トリー (4-メトキシ-3, 5-ジメチルフェニル) ホスフィン などが挙げられる。

また、コバルト化合物として、下記一般式(IV)で表される化合物を用いることができる。

15

9





上記一般式(IV)で表される化合物は、塩化コバルトに対し上記一般式(III)においてnが3であるホスフィン化合物を配位子に持つ錯体である。このコバルト化合物の使用に際しては、あらかじめ合成したものを使用してもよいし、あるいは重合系中に塩化コバルトとホスフィン化合物を接触させる方法で使用してもよい。錯体中のホスフィン化合物を種々選択することにより、得られるシンジオタクチック1,2一ポリブタジエンの1,2一結合の量、結晶化度の制御を行なうことができる。

上記一般式 (IV) で表されるコバルト化合物の具体例としては、コバルトビス (トリフェニルホスフィン) ジクロライド、コバルトビス [トリス (3 ーメチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3 ーエチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4 ーメチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3, 5 ージメチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3, 4 ージメチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3 ーイソプロピルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3 ー t ープチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3, 5 ージエチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3, 5 ージエチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、

20

コバルトビス [トリス (3-メチル-5-エチルフェニルホスフィン)] ジ クロライド、コバルトビス [トリス (3-フェニルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3, 4, 5-トリメチルフェニルホ スフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4-メトキシ-3, 5 -ジメチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4 -エトキシ-3, 5-ジエチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバ ルトビス [トリス (4-ブトキシ-3, 5-ジブチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4-メトキシフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (3-メトキシフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4-ドデシルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4-ドデシルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4-エチルフェニルホスフィン)] ジクロライド、コバルトビス [トリス (4-エチルフェニルホスフィン)]

これらのうち、特に好ましいものとしては、コバルトビス(トリフェニルホスフィン)ジクロライド、コバルトビス[トリス(3-メチルフェニルホスフィン)]ジクロライド、コバルトビス[トリス(3,5-ジメチルフェニルホスフィン)]ジクロライド、コバルトビス[トリス(4-メトキシー3,5-ジメチルフェニルホスフィン)]ジクロライドなどが挙げられる。

触媒の使用量は、ブタジエンの単独重合の場合は、ブタジエン1モル当たり、共重合する場合は、ブタジエンとブタジエン以外の共役ジエンとの合計量1モル当たり、コバルト化合物を、コバルト原子換算で0.001~1ミリモル、好ましくは0.01~0.5ミリモル程度使用する。また、ホスフィン化合物の使用量は、コバルト原子に対するリン原子の比(P/Co)と

して、通常、 $0.1\sim50$ 、好ましくは $0.5\sim20$ 、さらに好ましくは $1\sim20$ である。さらに、アルミノオキサンの使用量は、コバルト化合物のコバルト原子に対するアルミニウム原子の比(A1/Co)として、通常、 $4\sim10^7$ 、好ましくは $10\sim10^6$ である。なお、一般式(IV)で表される錯体を用いる場合は、ホスフィン化合物の使用量がコバルト原子に対するリン原子の比(P/Co)が2であるとし、アルミノオキサンの使用量は、上記の記載に従う。

重合溶媒として用いられる不活性有機溶媒としては、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クメンなどの芳香族炭化水素溶媒、nーペンタン、nーヘキサン、nーブタンなどの脂肪族炭化水素溶媒、シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサンなどの脂環族炭化水素溶媒およびこれらの混合物が挙げられる。

重合温度は、通常、 $-50\sim120$ ℃で、好ましくは $-20\sim100$ ℃である。

15 重合反応は、回分式でも、連続式でもよい。なお、溶媒中の単量体濃度は、 通常、5~50質量%、好ましくは10~35質量%である。

また、重合体を製造するために、本発明の触媒および重合体を失活させないために、重合系内に酸素、水あるいは炭酸ガスなどの失活作用のある化合物の混入を極力なくすような配慮が必要である。重合反応が所望の段階まで進行したら反応混合物をアルコール、その他の重合停止剤、老化防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤などを添加し、次いで通常の方法に従って生成重合体を分離、洗浄、乾燥して本発明に用いられるシンジオタクチック1,2-



ポリブタジエンを得ることができる。

本発明に用いられる(A)シンジオタクチック1,2ーポリプタジエンの重量平均分子量は、好ましくは1万~500万、さらに好ましくは1万~150万、特に好ましくは5万~100万である。重量平均分子量が1万未満では流動性が極端に高く、加工が非常に困難となり、また成形品がべたつくため好ましくなく、一方、500万を超えると流動性が極端に低く、加工が非常に困難となり好ましくない。

(B) 熱可塑性ポリマー

20

- (B) 熱可塑性ポリマーとしては、上記(A) 成分以外の熱可塑性樹脂お はび/または熱可塑性エラストマーであり、具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチレンーブタジエンースチレンブロック共重合体(SBS)、スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体(SIS)、これらの水素化物(SEBS、SEPS)、上記シンジオタクチック1,2ーポリブタジエン以外のポリブタジエン(BR)、ABS樹脂、ポリイソプレン、各種 ポリエチレン(LLDPE、ULDPE、LDPE)、エチレンー酢酸ビニルコポリマー、エチレンーアクリル酸エステルコポリマー、およびエチレンーメタクリル酸コポリマーの群から選ばれた少なくとも1種である。
 - (B) 成分の配合量は、(A) ~ (B) 成分の合計量100質量部中に、40質量部以下、好ましくは0~35質量部である。40質量部を超えると、(A) 成分の使用割合が少なくなり、柔軟性や硬度と透明性が失われる。
 - なお、本発明に用いられる組成物において、上記(A)~(B)成分以外に、必要に応じて、滑剤、フィラー、オイルまたは発泡剤などの添加剤を含

有してもよい。上記添加剤の具体例としては、エルカ酸アミド、ステアリン酸アミド、オレイン酸アミドなどの滑剤、タルク、シリカ、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、ガラス、カーボンファイバー、ガラスバルーンなどのフィラー、パラフィンオイル、シリコンオイル、エクスパンセル発泡剤(日本フィライト社取り扱いビーズ型発泡剤マイクロスフェアー:成形加工時にビーズが40倍以上に膨張)、ADCA(Azodicarbanamide)、OBSH(p, p'-oxybisbenzensulfonylhydrazine)、重曹、AIBN(アゾビスイソブチロニトリル)などの発泡剤を挙げることができる。

10 また、電子線照射による耐熱性と柔軟性を向上させるために、その他の添加剤、例えば、トリメチルプロパントリメタクリレートなどの多官能モノマー、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンなどの光重合開始剤、ベンゾフェノンなどの光増感剤などを、シンジオタクチック1,2ーポリブタジエン100質量部に対して5質量部以下含有させてもよい。

組成物の調製と成形

15

20

本発明に用いられる組成物は、上記(A)~(B)成分、これらにさらに必要に応じて、上記添加剤などを添加して、加熱軟化させて、混練し成形する。混練と成形は、シンジオタクチック1,2ーポリブタジエンの軟化温度ないし溶融温度以上の成形性の良好な温度範囲で行い、均質な成形品にする。このため、成形温度は、90~170℃程度が良い。成形品を得るには、プレス成形、押し出し成形、射出成形、ブロー成形、異形押し出し成形、Tダイフィルム成形、インフレーション成形、パウダースラッシュ成形、回転

成形などが利用される。

電子線照射

15

本発明の樹脂成形品は、次いで電子線を照射して得られる。電子線を照射 すると、シンジオタクチック1, 2 -ポリブタジエンのビニル基のラジカル 反応により三次元架橋構造となり、成形品を硬化させるとともに、耐熱性を 付与させる。

電子線は、合成樹脂に対して透過性があり、その透過の程度は、成形品の厚みと、電子線の運動エネルギーに依存する。

その照射厚みに従って厚み方向に均一に透過可能に電子線のエネルギーを 10 調節すると、厚み方向で架橋度を均一にした成形品とすることができる。

電子線のエネルギーは、上記の成形品に対して、好ましくは20~5,000kV、さらに好ましくは50~3,000kV、さらにより好ましくは100~2,000kVとする。20kVより小さいと、表層部で捕獲吸収される電子の割合が相対的に多くなって、成形品を透過する電子線が少なくなり、表層部に比して内部の架橋が遅れて、架橋度に差が生じるので、好ましくない。一方、5,000kVより大きいと、架橋度が大きくなり過ぎて、硬質となるので、弾力性や伸びが小さいので好ましくない。

また、この際の電子線の照射量は、好ましくは $0.1\sim200 \, \mathrm{Mrad}$ (S I 単位系で、 $1\sim2,000 \, \mathrm{kGy}$ に相当する)、さらに好ましくは0.5 $\sim100 \, \mathrm{Mrad}$ の範囲で照射して架橋硬化させる。 $0.1 \, \mathrm{Mrad}$ より少ないと、1,2-ポリブタジエンの架橋度が小さく、-方、 $200 \, \mathrm{Mrad}$ を超えると、架橋度が大きくなり過ぎて、硬質となるので、弾力性や伸びが

15

20

小さいので好ましくない。

電子線照射による架橋は、電子線エネルギーと照射量の積で表すことができ、本発明においては、電子線加速電圧(kV)と照射線量(Mrad)の積を、好ましくは2~1,000,000(kV・Mrad)、さらに好ましくは25~300,000(kV・Mrad)、さらにより好ましくは50~100,000(kV・Mrad)とする。2(kV・Mrad)より小さいと、表層部で捕獲吸収される電子の割合が相対的に多くなって、成形、品を透過する電子線が少なくなり、表層部に比して内部の架橋が遅れて、架橋度に差が生じるので、好ましくない。一方、1,000,000(kV・Mrad)より大きいと、架橋度が大きくなり過ぎて、硬質となるので、弾力性や伸びが小さいので好ましくない。

本発明の成形品に、上記のような電子線照射を施すことにより、M2/M1の比を、好ましくは1.01~2.5倍、さらに好ましくは1.02~2.0倍とすることができる。ここで、M2、M1は、電子線照射後の成形品の50%応力(50%M:M2)、電子線照射前の50%応力(50%M:M2)、電子線照射前の50%応力(50%M:M3)を意味する。1.01未満では、電子線架橋が進んでおらず、耐蒸気滅菌性に劣る。一方、2.5を超えると、架橋成形品が硬くなりすぎ、柔軟性が失われ好ましくない。M2/M1は、上記電子線加速電圧(kV)と照射線量(Mrad)の積を、好ましくは2~1,000,000(kV·Mrad)、さらに好ましくは25~300,000(kV·Mrad)、さらにより、容易に調整することができる。

15

20

また、このようにして得られる電子線照射後の架橋成形品は、耐蒸気滅菌性を有し、例えば、本発明の架橋成形品の一形態である輸液チューブを用いて、 $90\sim140$ で $10\sim20$ 分間程度、蒸気滅菌しても、変形することもない。

5 ここで、耐蒸気滅菌性とは、たとえば、輸液チューブなどの樹脂成形品(一例:内径 $3 \, \mathrm{mm} \, \phi$ 、外径 $4 \cdot 4 \, \mathrm{mm} \, \phi$ 、肉厚 $0 \cdot 7 \, \mathrm{mm} \, \mathrm{mo}$ チューブ、チューブ長 $2 \cdot 0 \cdot \mathrm{cm}$)を高圧蒸気滅菌器に入れ、 $1 \cdot 2 \cdot 1 \, \mathrm{cm} \, 2 \cdot 0 \cdot \partial \mathrm{ll}$ 、蒸気滅菌した場合、滅菌前の形状が保たれ、変形が観察されないことを意味する。

さらに、本発明の電子線を照射された樹脂成形品のヘイズ値は、50以下、 好ましくは30以下である。ヘイズ値は、透明性の尺度であり、その値が小 さくなる程、透明性がよくなる。このヘイズ値は、ASTM D-1003 に準拠して測定される値である。

また、電子線照射後の本発明の樹脂成形品は、トルエン不溶分が、通常、 50~99質量%、好ましくは80~95質量%である。トルエン不溶分は、 樹脂成形品を電子線照射することにより、(A)シンジオタクチック1,2 ーポリブタジエン中の二重結合がどの程度架橋しているかを示すバロメーターである。

ここで、トルエン不溶分は、本発明の樹脂成形品 [(a) g] を100m 1のトルエンに浸漬させ、<math>30 ℃で48 時間振とう後、100 メッシュ金網を用いて濾過し、濾過液の一部 [(c) m 1] を採取後、蒸発乾燥固化させ、得られた残存固形分 [トルエン可溶分:(b) g] を秤量し、下式によりゲル含有量を算出した。

10

15

20

実施例

ゲル含有量(質量%) = $[\{a-b\times(100/c)\}/a]\times100$ トルエン不溶分が 50 質量%未満では、電子線照射による架橋が不充分であり、耐熱性が劣り、耐蒸気滅菌性に劣る。一方、99 質量%を超えると、電子線照射による架橋が進みすぎて、樹脂成形品が硬くなりすぎ、柔軟性が失われ好ましくない。

上記トルエン不溶分は、上記電子線加速電圧(kV)と照射線量(Mrad)の積を、好ましくは $2\sim1$, 000, 000($kV\cdot Mrad$)、さらに好ましくは $25\sim300$, 000($kV\cdot Mrad$)、さらにより好ましくは $50\sim100$, 000($kV\cdot Mrad$) とすることにより、容易に調整することができる。

さらに、本発明の樹脂成形品は、ハロゲン原子の含有量が50ppm以下、好ましくは20ppm以下である。このハロゲン原子の含有量は、例えば、上記のように、重合溶媒として非ハロゲン系の不活性有機溶媒を用いることにより、得られる1,2一ポリブタジエン中のハロゲン原子の含有量を50ppm以下、好ましくは20ppm以下にすることができる。また、触媒系において、非ハロゲン系の化合物のみを用いることは、樹脂成形品中のハロゲン原子の含有量をさらに低減させることができ好ましい。

本発明の樹脂成形品は、柔軟性と硬度とに優れ、かつ耐蒸気滅菌性を有するシンジオタクチック1,2-ポリブタジエン含有成形品であり、輸液用チューブ、輸液用容器、およびカテーテルなどの医療用途に有用である。

以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下

の実施例に限定されるものではない。なお、実施例中、部および%は特に断らない限り、質量基準である。また、実施例中の各種の測定は、以下に従った。

耐蒸気滅菌性:

5 本文中に記載

透明性(ヘイズ値):

本文中に記載

引張強度、引張破断伸び、引張弾性率:

JIS K6301に準拠し、試験速度200mm/分、つかみ具間距離 10 50mmで測定した。

ゲル分率:

本文中に記載

硬度:

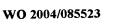
電子線照射後の成形品の50%応力(50%M:M2)が5MPa以下を 15 硬度が高くなく、良とした。

柔軟性:

電子線照射後の引張破断伸びが100%以上を良とした。

実施例1

 1,2一ポリブタジエン(JSR社製、商品名:JSR RB810、結
 20 晶化度=18%)100質量部を押出し成形にて、内径3mmφ、外径4. 4mmφ、肉厚0.7mmのチューブに成形し、これを電子線照射装置(日新ハイボルテージ社製、商品名:EPS800-35)を用いて、加速電圧



300kV、照射線量20Mradで電子線照射処理を行った。評価結果を表1に示す。

実施例2

実施例1において、電子線の加速電圧を800kVに変えたこと以外は、 実施例1と同様にした。評価結果を表1に示す。

実施例3

実施例2において、電子線の照射線量5Mradに変えたこと以外は、実施例2と同様にした。評価結果を表1に示す。

実施例4

10 実施例3において、1,2-ポリブタジエンにSIS (スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体、JSR社製、JSR SIS 5229P)を30質量%ブレンドしたものを用いたこと以外は、実施例3と同様にした。評価結果を表1に示す。

比較例1

15 実施例1において、1,2-ポリブタジエン100質量部を押出し成形したチューブを電子線照射せずに評価した。評価結果を表1に示す。

比較例2

実施例1において、電子線の加速電圧を30kVに、照射線量0.05Mradに変えたこと以外は、実施例1と同様にした。評価結果を表1に示す。

20 比較例3

実施例2において、電子線の加速電圧を5,000kVに、照射線量300Mradに変えたこと以外は、実施例1と同様にした。評価結果を表1に

T/JP2004/003964

示す。

10

表 1

<u> </u>			実施例			比較例			
1			1	2	3	4	1	2	3
材料	(*1) RB		100	100	100	70	100	100	100
'' '	(*2) S I S					30			
照射	①加速電圧	(kV)	300	800	800	800	無	30	5000
条件	②照射線量	(Mrad)	20	20	5	5	無	0.05	300
	①×②の積		6000	1600	4000	4000		1.5	1500000
	耐蒸気滅菌性	形状	0	0	0	0	×	×	0
ŀ		保持							
	透明性	ヘイズ	15	14	16	20	18	17	9
	引張強度	(MPa)	12	16	20	22	14	15	14
	引張破断伸び	(%)	410	210	720	790	910	870	10
	照射前引張	M1 (MPa)	3.4	3.4	3.4	3.2	3.4	3.4	3.4
	50%応力(M1)					<u> </u>		<u> </u>	
	照射後引張	M2 (MPa)	3.6	4.0	3.5	3.3	_	3.4	10.0
1	50%応力(M1)								
	照射前との	(-)	1.06	1.18	1.03	1.03	_	1.00	2.94
1	M50比								100
	ゲル分率	(%)	57	99	91	87	0	30	100

(*1) RB; 1, 2-ポリブタジエン(JSR社製、商品名:JSR RB810、結晶化度=18%

5 (*2) SIS; (スチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体、J SR社製、JSR SIS 5229P)

表1に示すように、本発明の電子線照射条件が、電子線加速電圧(kV)と照射線量(Mrad)の積で2~1,000,000(kV・Mrad)を満足する実施例1は、照射条件を満足しない比較例1(照射無し)および比較例2(加速電圧:30kV、照射線量:0.05Mrad)に比べ耐熱性(蒸気滅菌性)が向上し、また柔軟性に優れていることが分かる。

また、実施例1における加速電圧300kVを800kVに高めた実施例

T/JP2004/003964



2でも、耐熱性(蒸気滅菌性)が向上していることが分かる。

さらに、実施例3は、実施例2における照射線量20Mradを5Mradに下げたものであるが、耐熱性(蒸気滅菌性)が向上し、さらに柔軟性に優れた結果となっている。

5 実施例4は、実施例3における照射条件で、1,2ーポリプタジエンにS IS (スチレンーイソプレンースチレンブロック共重合体、JSR社製、JSR SIS 5229P)を30質量部ブレンドしたものを用いたものであるが、耐熱性(蒸気滅菌性)と柔軟性に優れた結果となっている。

一方、比較例1は、電子線照射を実施していないチューブであり、耐熱性 10 (蒸気滅菌性)が劣る。

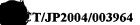
比較例 2 は、電子線照射条件が、電子線加速電圧 (kV) と照射線量 (Mrad) の積で $2\sim1$, 000, 000 $(kV\cdot Mrad)$ を下まわっており、耐熱性 (蒸気滅菌性) が劣る。

比較例 3 は、電子線照射条件が、電子線加速電圧(kV)と照射線量(M rad)の積で2~1,000,000(kV・Mrad)を上回っており、 柔軟性が劣る。

産業上の利用可能性

本発明の樹脂成形品は、柔軟性と硬度とに優れ、また耐蒸気滅菌性を有す 20 るので、チューブ、シート、フィルム、バッグ、コネクターなどの用途に有 用である。特に、輸液チューブ、輸液容器、およびカテーテルなどの医療用 途に有用である。

また、本発明の樹脂成形品を同様の電子線照射により加工して得られる加工品は、食品用途、履き物用途、車両用途、電線被覆用途などにも有用である。



請求の範囲

- 1. (A)結晶化度が5%以上であるシンジオタクチック1,2-ポリブ タジエン100~60質量部、ならびに(B)ポリエチレン、ポリプロピレ ン、スチレンープタジエンースチレンプロック共重合体(SBS)、スチレ ンーイソプレンースチレンブロック共重合体 (SIS)、これらの水素化物 (SEBSまたはSEPS)、上記シンジオタクチック1,2-ポリブタジ エン以外のポリブタジエン (BR)、ABS樹脂、ポリイソプレン、ポリエ チレン (LLDPE、ULDPEまたはLDPE)、エチレン-酢酸ビニル コポリマー、エチレン-アクリル酸エステルコポリマー、およびエチレン-メタクリル酸コポリマーの群から選ばれた少なくとも1種の熱可塑性ポリマ -0~40質量部 [ただし、(A)+(B)=100質量部] を含有する樹 脂成形品を電子線照射して得られる成形品であって、電子線照射後の成形品 の 5 0 % 応力 (5 0 % M: M2) が電子線照射前の 5 0 % 応力 (5 0 % M: M1) の1.01~2.5倍であり、かつ耐蒸気滅菌性を有することを特徴 15 とする樹脂成形品。
 - 2. 2 mmシートのヘイズ値が50以下の透明性を有する請求の範囲第1 項記載の樹脂成形品。
- 3. 電子線照射後のトルエン不溶分が50~99質量%である請求の範囲 20 第1項または第2項記載の樹脂成形品。
 - 4. 電子線照射量が、電子線加速電圧(kV)と照射線量(Mrad)の 積で2~1,000,000(kV·Mrad)である請求の範囲第1~3



いずれかに記載の樹脂成形品。

- 5. 成形品形態がチューブ、シート、フィルム、バッグ、およびコネクターの群から選ばれた少なくとも1種である請求の範囲第1~4項いずれかに記載の樹脂成形品。
- 5 6. ハロゲン原子の含有量が 5 0 p p m以下である請求の範囲第 1 ~ 5 項 いずれかに記載の樹脂成形品。
 - 7. 医療用途である請求の範囲第1~6項いずれかに記載の樹脂成形品。
 - 8. 請求の範囲第1~7項いずれかに記載の樹脂成形品を加工して得られる加工品。
- 10 9. 食品用途、履き物用途、車両用途、または電線被覆用途である請求の 範囲第8項記載の加工品。



-

International application No.

PCT/JP2004/003964

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08J7/00, C08L9/00										
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC										
B. FIELDS SEARCHED										
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)										
Int.Cl ⁷ C08J7/00, C08L9/00-9/10										
	·									
Documentation searched other than minimum documentation to the ext										
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 J	oroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 itsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004									
Electronic data base consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search terms used)									
	·									
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT										
Category* Citation of document, with indication, where a										
A JP 7-179675 A (Nippon Petroc 18 July, 1995 (18.07.95),	chemicals Co., Ltd.), 1-9									
Column 1, lines 2 to 22; column 1	umn 4. lines 44 to 48:									
column 5, lines 5 to 12; column	umn 14, line 41 to									
column 15, line 4 (Family: none)										
(ramily: none)										
·	· ·									
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.									
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered	"I" later document published after the international filing date or priorit date and not in conflict with the application but cited to understand									
to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international	the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be									
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone									
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is									
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than	combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art									
the priority date claimed	"&" document member of the same patent family									
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report									
14 April, 2004 (14.04.04)	27 April, 2004 (27.04.04)									
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer									
Facsimile No.	Telephone No.									
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)	,F									





国際出願番号 PCT/IP2004/003964

		34/003904							
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl'CO8J 7/00、CO8L 9/0	0	·							
B. 調査を行った分野									
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))	0 4 5								
Int. C1'C08J 7/00, C08L 9/00- 9/10									
·									
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの									
日本国実用新案公報 1926-2004年	·								
日本国公開実用新案公報 1971-2004年									
日本国登録実用新案公報 1994-2004年		į							
日本国実用新案登録公報 1996-2004年	•								
原映部大学は四1 よんラブ トン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・									
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)								
		Ì							
·]							
C. 関連すると認められる文献									
引用文献の		関連する							
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号							
A JP 7-179675 A (日本									
A JI 7 17 30 7 5 A (日本)	口何亿子休八云红)	1 - 9							
1995.07.18、第1欄第2-	-22行、第4欄第44-48								
行、第5欄第5-12行、第14欄鎖	₹41行ー第15欄第4行(フ │								
アミリーなし)									
<u> </u>	•								
									
C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。							
. 310-th a.s tu									
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献								
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ								
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、矛	8明の原理又は理論							
以後に公表されたもの	の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当	/8+++h ~ 7 50 00							
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「A」 特に関連のめる又献であって、≡ の新規性又は進歩性がないと考え								
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当								
文献(理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自								
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	いたの							
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献								
国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日	000							
14.04.2004	27. 4.	2004							
CESTION ATTO-LUMBER OF ACT TO AND ACT									
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4 J 9 2 6 8							
日本国特許庁(ISA/JP)	森川 聡								
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	(新社本日 00 0 E 0 f 1 f 1 f 1								
ボルボール円位段が第二】日4食3万	電話番号 03-3581-1101	四級 3456							